

Cristalografia

Karla Balzuweit Dep. De Física – ICEx – UFMG Centro de Microscopia da UFMG







Morfologia

Hoje em dia:

MUITO MAIS QUE UMA GRANDE LUPA!!

Química

Estrutura



Classificações dos Estados da Matéria

- ➢ Os três "clássicos" − sólido, líquido, gasoso;
- > Mais recentemente: 4° estado plasmático (T >>),
 - 5° estado condensado de Bose-Einstein (T <<);
- Outros: supersólido, superfluido, cristal líquido, fluido supercrítico, coloidal, matéria degenerada, sólido amorfo (vítreo, não-vítreo) x sólido cristalino, condensado fermiônico, plasma quark-glúon, matéria fracamente simétrica, fortemente simétrica, etc.

Estado sólido:

sólidos cristalinos x não-cristalinos

(= amorfos). Sólidos vítreos: caso particular de nãocristalino









Água marinha



Janet Anneberg Hooker Hall of Geology, Gems and Minerals: http://www.si.edu/resource/faq/nmnh/mineralsciences.htm



Topázio Imperial





http://docenten.science.ru.nl /Janner/le/ape.pdf



S UNIVERSIT

CARL WINTERS UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG HEIDELBERG 1922

https://www.mindat.org/mesg-6-433642.html





Corundum $- AI_2O_3$



https://pt.wikipedia.org/wik i/Cor%C3%ADndon







Goniômetro óptico

No.-0469 (10502)

2+ 0.400 (cased)

0012



https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyc lop%C3%A6dia_Britannica/Goniometer

Calaverite AuTe₂



http://www.mineralogy.eu/gonio.html







Cristalografia

- Cristalografia = descrição de cristais
- Cristal do grego "krystallos" = gelo
- Cristal sólido homogêneo, que possui arranjo interno (atômico) tridimensional, com ordem de longo alcance (= *long-range order*).
- Cristalografia: originalmente um ramo da Mineralogia, relativamente tardio entre as Ciências – iniciou-se no século XVII (Steno, Carangeot, de l'Isle, Haüy)







Nicolau Steno (Niels Stensen) 1638 – 1686

- médico, naturalista e teólogo
- estudo sobre a constância dos ângulos entre as faces dos cristais
- contribuições fundamentais para a paleontologia e para a estratigrafia
- grande anatomista, descobriu as glândulas lacrimais (*glândulas de Steno*)







Lei da Constância dos Ângulos por Nicolas Steno (Niels Stensen)



Início da Cristalografia como Ciência":

Descoberta da lei da Constância dos Ângulos por Nicolas Steno (Niels Stensen) em 1669, observado em cristais de quartzo. Apesar dos diversos espécimes de cristais de quartzo não serem perfeitamente iguais quanto ao tamanho e contorno das faces, o ângulo entre faces equivalentes de vários espécimes era sempre constante.







Cristais formados pelo empacotamentos de minúsculos blocos idênticos (conceito precursor das "celas unitárias")











- Átomos estão dispostos em posições regulares no espaço.
- Descrição: rede + base
 - Rede = estrutura geométrica
 - Base = distribuição dos átomos ou conjunto de atomos em cada ponto da rede.







Geometria

Teoria de grupo

- Padrões
- Simetria
- Regras
- Definições

Livro Escher







Tesselation - tilings









Existe um número finito de organizar os "átomos" ou "padrões" de tal forma que se preenche todo o plano ou o espaço.

- 1 DIMENSÃO
- 7 grupos de espaço

- 3 DIMENSÕES
- 7 sistemas cristalinos
- 14 redes de Bravais
- 32 grupos de ponto
- 230 grupos de espaço

- 2 DIMENSÕES
- 4 sistemas cristalinos
- 5 redes de Bravais
- 10 grupos de ponto
- 17 grupos de espaço







Uma rede é definido por 3 vetores tal que:

r' = **r** + u**a** + v**b** + w**c**

onde, u, v, w = inteiros Ponto r' é idêntico ao ponto r.

Ex. Rede cúbica de face centrada com 2 átomos por ponto de rede.

(cristal de NaCl)





Definição dos parâmetros de rede



 $b^c = \alpha$

 $a^c = \beta$

 $a^b = \gamma$





Redes em 2 dimensões





Tetragonal







Simetria

Simetria: é a propriedade decorrente da repetição ordenada das partes de um todo.

A simetria pode ser descrita através dos padrões de repetição ordenada das partes equivalentes: o mecanismo responsável por esta repetição se denomina <u>operador de simetria</u>.

Os operadores de simetria observados em substâncias cristalinas podem ser: <u>translação</u>, <u>rotação</u>, <u>inversão</u>, <u>reflexão</u> e (glide) <u>deslizamento</u> que podem ocorrer combinados.





Operações de Simetria

- **1) Translação** $\rho(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r} + u.\mathbf{a} + v.\mathbf{b} + w.\mathbf{c});$
- 2) Rotação: eixos de simetria (E_n em inglês, A_n, de *axis*);
- 3) Reflexão ou espelho: planos de simetria (m de mirror, espelho);
- Inversão ou centro de inversão: centro de simetria (i de inversão ou -1);
- Rotoinversão ou combinação de rotação com inversão: (-3.-4, -6). A operação -2 é equivalente à reflexão, logo não é uma simetria nova.
- 6) Parafuso: combinação de rotação com translação (screw axis) de ordem 2 (2₁), ordem 3(3₁ e 3₂), ordem 4 (4₁, 4₂, 4₃) e de ordem 6 (6₁,6₂, 6₃, 6₄, 6₅)
- Combinação de rotação com reflexão de ordem 2 (2/m), ordem 4 (4/m), ordem 6 (6/m).
- 8) Combinação de um eixo parafuso (screw axis) com reflexão: ordem 2 (2_1 /m), ordem 4 (4_2 /m) e ordem 6 (6_3 /m).
- 9) Plano de deslizamento: combinação de uma reflexão com translação: a,b,c,n,e,d

Os elementos de simetria podem ser:

- a) <u>próprios</u> (objetos direitos geram apenas objetos direitos, e vice-versa) <u>eixos de</u> <u>simetria simples;</u>
- b) <u>impróprios</u> (objetos direitos geram objetos esquerdos, e vice-versa) <u>planos, centro</u> <u>de simetria e eixos de roto-inversão</u>







CRISTALOGRAFIA

- "DEFINIÇÃO CLÁSSICA"
- Ordem de longo alcance
- Ordenamento periódico dos átomos em 3-dimensões
- Simetria de translação: $\mathbf{R} = \mathbf{u}\mathbf{a} + \mathbf{v}\mathbf{b} + \mathbf{w}\mathbf{c}$



Simetria

+

Base





Crystal family (6)	Crystal system (7)	Required symmetries of point group	Point groups	Space groups	Bravais lattices	Lattice system	
Triclinic		None	2	2	1	Triclinic	
monoclinic		1 twofold axis of rotation or 1 mirror plane	3	13	2	monoclinic	
Orthorhombic		3 twofold axes of rotation or 1 twofold axis of rotation and 2 mirror planes.	3	59	4	Orthorhombic	
Tetragonal		1 fourfold axis of rotation	7	68	2	Tetragonal	
Hexagonal	Trigonal	1 threafold avis of rotation	5	7	1	Rhombohedral	
	mgunai		U	18	4	Hovagonal	
	Hexagonal	1 sixfold axis of rotation	7	I	пелауона		
Cubic		4 threefold axes of rotation	5	36	3	Cubic	
6	7	Total	32	230	14	7	



https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_system





- Os componentes do vetor são dados como múltiplos dos vetores de base.
- A direção da diagonal em sistema tipo paralelepípedo tem as componentes 1a, 1b, 1c, ou seja: [111]
- Em cristal cúbico, a direção [l,m,n] é perpendicular ao plano (l,m,n). Ex. [100] é perpendicular ao plano (100)





Planos e Direções Cristalográficas



Ω

2α

В



Índices de Miller:

- a) Distâncias das intersecções
- b) Tomar inversos dos valores

c) Reduzir os resultados a números inteiros com a mesma relação entre si y Ex.: 2 x ¹/₂ = 1; 2 x ¹/₂ = 1; 2 x 1 = 2 ⇒ plano (1,1,2) ou (112)

А

2α



Grupo de espaço (227) Fd -3m (silício, alumínio, etc)

F 13	07	512-000													
Fasm	O _h	m 3 nt	Cubic	CDA	H NU	113							No. 227		Fd
No. 227	$F = 4_1/d = 3 = 2/m$	Par	атол султалу Г «См												
outers choice 1				Ganad	win i	slated	0.051	0.4.15	10,1,1	(1999,1)		1.184.15	n. 18; (15: 10)	. (21)	
1=	10	u		Paulie	-			00154	-						Induction statistics
- AN .	ā.,	ř., ř.,		Sec. or	1944 1947		kynvol	i ind	die B	a,4)+	(<i>i</i> , <i>i</i> , <i>i</i>);				A.k.i premiaite General
μ ∦ 8 ° γ 1				142		自当 自当 同当 同当 に 同当 に 同当 に に 同当 に に 同当 に に 同 に に に の に に の に の に の に の に の の い に の の い に の の い に の い の い の い い の い い い い い い い い い い い い い					0.1. (0.1.) (0.1.) (0.1.) (0.1.) (0.1.) (0.1.) (0.1.) (0.1.) (0.1.) (0.1.) (0.1.)	$\begin{array}{c} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\$	$\begin{array}{c} (0,x) + (\sqrt{2},2) \\ (0,1) + (\sqrt{2},2) + (\sqrt{2},2) \\ (10,1) + (\sqrt{2},2) \\ (10,1) + (\sqrt{2},2)$		$\begin{array}{l} MJ = A + A + 2\pi \mbox{ sol} \\ A = J A + J A + 2\pi \mbox{ sol} \\ M = J A + 2A + 2A \\ M = J A + 2A \\ M = J $
440 m PT		取りキルトリ										1.1600		-	and second practices
ľ							1991-10 91-10 191-10 191-10 21-31-10 21-32	212222	1,131 1,131 1,34 1,34 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57	1010 101 101 101 101 101 101 101 101 10		1.5,714 7.1,19 5.7.1,8 5.7.1,9 5.8,714 7.4,7,5			
44 0 - 50 1 7	Q K	QTXX		96.		-	1.1.1 1.1 1.	1.1.1 1.1 - 1 1.1 - 1	1.3 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1	112 (1 22) 1 22) 1 23 1 24 1 24 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25	12 12 11 11 11		1-141-14 1-141-14 1-141-14 1-141-14 1-141-14		azostine
	Upper Mit o	politen miy		.88	1 2	-	1.0.0 1.0.1 S	23	ia.	8.48 8+1.61		Li List	a tila	M	2-3+1 0 81812-30
80 <u>.</u> 6	1.8 9.6	Le qq	- C	52	د ،		111 31 13 31 131 31 13 31 13 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3	141	1.14 1.14 1.14					-18	ntsonalites
38° 39	1 12 B	10 0°0	100		- 3	*	14.1	1.1.1	11.1	1.1.5	i i			16	4-201
122		M TR T		-16	1	5.0	4.4.1	4.4.4	1.8.3	14.1	£			- 22	* 8,87 B
100 B	FR (9-6	10 00			· 41		141	1.1.1	}					740	8-30-1 8-8-4-7-46
Origin a Cor, at $-i_1 - i_2 - i_1$ Asymmetric and $0 \le x$ Votices 0.00	Been coddm (7eg) Sik (95y54) -455554, y5 1840 1441 1441 148 48 4	nie34-e.1195253 6-1		Second Along R' = 1) Chigas	(07) ((00) (() () () () () () () () () () () () ()	Lupethi Ann E -	il projec	Sien	All a- Oly	g (111) pel esta a marca a	aa c) a	~ + _+;=	4	itagi () 	10(√2000 1,3) ¥'-+ 1,1,1
Santosteficano															

International Table of Crystallography -Vol.A (2005) IUCr http://it.iucr.org/

26

Fd3m



Crystallographic Information File (CIF) sers/pierrestadelmann/Desktop/jemsNetBeans/ Silício

file//Users/pierrestadelmann/Desktop/jemsNetBeans/ jemsData/Cubic/Si.txt name|Si creator|pierrestadelmann date|Tue Sep 27 16:06:06 CEST 2011 system|cubic superCell|false HMSymbol|227|48|0|1|0| F d 3 m rps|24|1/4 - x, 1/4 - y, 1/4 - z rps|0|x, y, zrps|25|1/4 - z, 1/4 - x, 1/4 - y rps|1|z, x, yrps|26|1/4 - y, 1/4 - z, 1/4 - x rps|2|y, z, xrps|27|1/4 - x, 1/4 + y, 1/4 + zrps|3|x, z, yrps|28|1/4 - z, 1/4 + x, 1/4 + yrps|4|y, x, zrps|29|1/4 - y, 1/4 + z, 1/4 + xrps|5|z, y, xrps|30|1/4 + x, 1/4 - y, 1/4 + zrps|6|x, -y, -zrps|7|z, -x, -y rps|31|1/4 + z, 1/4 - x, 1/4 + yrps|32|1/4 + y, 1/4 - z, 1/4 + xrps|8|y, -z, -x rps|33|1/4 + x, 1/4 + y, 1/4 - zrps|9|x, -z, -y rps|34|1/4 + z, 1/4 + x, 1/4 - yrps|10|y, -x, -z rps|35|1/4 + y, 1/4 + z, 1/4 - xrps|11|z, -y, -x rps|36|1/4 - x, 1/4 - z, 1/4 - y rps|12|-x, y, -z rps|13|-z, x, -y rps|37|1/4 - y, 1/4 - x, 1/4 - z rps|38|1/4 - z, 1/4 - y, 1/4 - x rps|14|-y, z, -x rps|39|1/4 - x, 1/4 + z, 1/4 + yrps|15|-x, z, -y rps|40|1/4 - y, 1/4 + x, 1/4 + zrps|16|-y, x, -z rps|41|1/4 - z, 1/4 + y, 1/4 + xrps|17|-z, y, -x rps|42|1/4 + x, 1/4 - z, 1/4 + yrps|18|-x, -y, z rps|19|-z, -x, y rps|43|1/4 + y, 1/4 - x, 1/4 + zrps|44|1/4 + z, 1/4 - y, 1/4 + xrps|20|-y, -z, x rps|21|-x, -z, y rps|45|1/4 + x, 1/4 + z, 1/4 - yrps|46|1/4 + y, 1/4 + x, 1/4 - zrps|22|-y, -x, z rps|47|1/4 + z, 1/4 + y, 1/4 - xrps|23|-z, -y, x

lattice|0|0.54309 lattice|1|0.54309 lattice|2|0.54309 lattice|3|90.0 lattice|4|90.0 lattice|5|90.0 atom|0|Si,a,0.000,0.000,0.000,0.0049,1.000,0.029,Def,0 aff|0|Si|2.129,57.775,2.533,16.476,0.835,2.88,0.322,0.386|Doyle -Turner Acta Cryst. A24 (1968), 390 aff|0|Si|0.120120145,70.63101,1.0649803,1.0460037,0.1822563,0. 086886690.03060761,0.2147628,1.1086769,3.6920595,1.5825809 ,9.931198|Earl J. Kirkland, Advanced Computing in Electron Microscopy nsl|0|Si|0.415 aff|0|Si|0.0567,0.0582,0.3365,0.6155,0.8104,3.2522,2.496,16.7929 ,2.1186,57.6767|L. Peng et al., Acta Cryst. A52 (1996) 257-276::Def aff|0|Si|6.2915,2.4386,3.0353,32.3337,1.9891,0.6785,1.541,81.693 7,1.1407|XRay:: RHF::Def

CIF Si-file – JEMS – Pierre Stadelmann http://www.jems-saas.ch/

http://www.crystallography.net/cod/



Cristalografia moderna



- Wilhelm Roentgen (1895)
- descoberta dos raios X



- Max von Laue
- 1912 primeiros experimentos de difração de raios X em cristais;
- prêmio Nobel de Física em 1914





Difração em diversos diversas formas cristalinas



Carbono Amorfo Silício monocristalino Ouro policristalino Silício monocristalino – CBED

FIGURE2.1.3. Several kinds of D B obtained from a range of matariak in a conventional 100-kV TEM: (A) amorphous carbon, (B) an Al single crystal, (C) polycrystalline Au, (D) Si illuminated with a convergent baten of slatetrons. In all cases the direct baten of doctrons is responsible for the bright intensity at the center of the pattern and the scattered batens account for the spots or range that appear around the direct baten.

Transmission Electron Microscopy Williams and Carter 2009



Difração

- Difração de Fraunhofer
- espalhamento por ondas planas
 - aproximação longe da amostra
 - plano focal da lente objetiva no TEM
 - elétrons retroespalhados pela amostra

Difração de Fresnel

 – espalhamento por ondas não planas, por exemplo, esféricas









Interação radiação amostra

Raios X

- Interação com a nuvem eletrônica
- Densidade eletrônica

Elétrons

 Interação com a nuvem eletrônica e o núcleo

• Potencial eletrostático

A intensidade dos "pontos" tem origem diferente







Difração de elétrons

- Microscopia Eletrônica de Varredura
 - Channeling
 - Difração de elétrons retroespalhados (EBSD)

- Microscopia Eletrônica de Transmissão
 - Difração de area selecionada (SAD)
 - Dark field bright field
 - Microdifração
 - Difração de feixe convergente (CBED)
 - Difração de feixe convergente de altos ângulos (LACBED)
 - Determinação de estrutura cristalina
 - Precession electron diffraction (PED)
 - Template matching
 - Structure determination
 - Rotation electron diffraction (RED)
 - etc.....





Difração de elétrons: padrão de difração



Figure 3.2 The scattering of an incident beam of electrons (I) by a crystalline specimen. Intense beams of electrons may emerge from the other side of the specimen undeviated (T) or having been diffracted (D) from atomic planes of spacing d. In other directions (e.g. N) no intense beams will be formed.



Electron Microscopy and Analysis; P.J.Goodhew, J. Humphreys, R. Beanland; Taylor and Francis (2001)







1984



Padrão de difração de elétrons de um quasicristal de AlCuFe – Karla Balzuweit e Gustaav van Tendeloo 1991





Difração: cópio eletrônico e tran

microscópio eletrônico e transmissão

Convergência do feixe

- Paralelo: difração de Fraunhofer
- Convergente
 - Microdifração
 - CBED
 - Determinação de grupos de ponto e de espaço
 - LACBED
 - Estudo de defeitos

Feixe paralelo: difração de Fraunhofer – matemática de Fourier

- Posição dos "spots":
 - fator de estrutura

$$F(0) = \sum_{i}^{\infty} f_i e^{2\pi i (hx_i + ky_i + lz_i)}$$

- difração convencional
- Intensidade dos "spots":
 - fator de espalhamento atômico
 - Determinação de estrutura





Interação radiação-amostra

- Conservação de energia mecânica
 - Elásticas
 - não há perda de energia, ou a mesma é desprezível
 - Inelásticas
 - há perda de energia
- Conservação de momento linear e angular
- Colisões de uma única partícula
- Colisões de muitas partículas ou colisões múltiplas (situação na amostra).







Espalhamento elástico

- Coerente, se a amostra for fina e cristalina
- Baixos ângulos de espalhamento (1 a 10 graus)
- Ângulos maiores que 10 graus o espalhamento se torna incoerente
- Espalhamento inelástico é em geral incoerente, mesmo menor de 10graus.

- Aproximação cinética espalhamento único
- Aproximação dinâmica espalhamento plural ou múltiplo



Espalhamento múltiplo





Fig. 7.26. Electron diffraction patterns of Si foils at E = 100 keV with increasing thickness (a) t = 80 nm, (b) 800 nm, (c) 1500 nm with the electron beam parallel to [111] Pattern (a) shows diffraction spots of the zero- and first-order Laue zones; (b) shows defect and excess Kikuchi lines at medium angles and defect Kikuchi bands at low angles. In (c) the centre shows only Kikuchi bands and the region of excess and defect Kikuchi lines is shifted towards larger angles



Padrões de Kikuchi em um MET



Introduction to Texture Analysis: Macrotexture, Microtexture and Orientation Mapping, Olaf Engler and Valerie Randle – CRC Press - 2010

FIGURE 6.1

Formation of Kikuchi patterns in transmission geometry in TEM. (a) Origin of Kikuchi lines by inelastic scatter of the electrons, giving Bragg diffraction at source S on lattice planes (*lkl*). (b) Kikuchi pattern from austenitic steel (accelerating voltage 200 kV). (Courtesy of S. Zaefferer.) (c) Formation of excess and defect Kikuchi lines.





SAD e linhas de Kikuchi



FIGURE 8.6

Simulated diffraction patterns for a [100] axis showing both SAD spots and Kikuchi lines for (a) untilted, that is, exact [100] orientation and (b) 2° tilted orientation. These patterns show that Kikuchi lines have much greater sensitivity to crystal orientation than SAD spots (simulation program TOCA by Zaefferer, 2002).



Introduction to Texture Analysis: Macrotexture, Microtexture and Orientation Mapping, Olaf Engler and Valerie Randle – CRC Press - 2010





Padrões de Kikuchi em um MEV

Introduction to Texture Analysis:

CRC Press - 2010





Macrotexture, Microtexture and Orientation Mapping, Olaf Engler and Valerie Randle –

FIGURE 6.2

(b)

Formation of backscattered Kikuchi patterns by EBSD in SEM. (a) Origin of Kikuchi lines from the EBSD (i.e., tilted specimen) perspective. (b) EBSD pattern from copper (accelerating voltage 15 kV). (Courtesy of S. Zaefferer.)



ELECTRON BACKSCATTER DIFFRACTION - EBSD HISTORICAL OVERVIEW

Kikuchi pattern is a projection of the geometry of the crystal lattice from a volume of specimen. The pattern consists of pairs of band-like parallel lines (Kikuchi bands or lines).



Kikuchi pattern from the cleavage surface of galena



Magalhães (2003)

• Similar to "remarkable lines" obtained by Kikuchi (1928 *apud* Coates, 1967).

centro

microscopia

- Comparable ones were acquired by Alam *et al.* (1954).
- Scanning electron microscopy based observations were reached by Coates (1967): selected area electron channeling patterns (SACP, SAC or ECP).

 Venables & Harland (1972) published the first results achieved by SEM, which were named electron backscatter patterns (EBSPs), although the Backscatter Kikuch Pattern (BKP) was also a known name.





EBSD HISTORICAL OVERVIEW



Kikuchi pattern is a projection of the geometry of the crystal lattice from a volume of specimen. The pattern consists of pairs of band-like parallel lines (Kikuchi bands or lines).



Schematic illustration of the features of Kikuchi pattern

Randle (2003)

• Great advance with live video imaging and computer assisted indexing (Dingley, 1984).

• 1985: More extensive use of generic computer software — applicable for all crystal systems in theory; however, in practice, it was applied only for cubic and hexagonal systems.

• In the beginning of 1990, fully automatic pattern recognition and indexing was set out.

• The Hough Transform was the procedure suited for shaping the position of Kikuchi bands.

• The full automation led to the mapping of crystallographic orientation, allowing the use of a new term : "Orientation Image Microscopy" (Adams et al.,1993).





SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

FEG – Quanta 200 FEI











https://www.ebsd.info/pdf/A99_MicrToday_16(2008)_IBP.pdf

https://www.ebsd.info/TKD-EBSD.htm

Transmission EBSD from 10 nm domains in a scanning electron microscope (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/51808960_Tra nsmission_EBSD_from_10_nm_domains_in_a_scannin

g_electron_microscope [accessed Jun 4, 2017]



Análise de grãos:

Difração de elétrons retroespalhados – EBSD



Figure 1 A view of the inside of the SEM's specimen chamber showing the specimen and the SE, BSE and EBSD detectors.





Figure 3 The EBSD pattern obtained from the position in figure 2 marked by the green cross. Each band in this pattern is produced by a specific set of crystallographic planes. The angles of the bands tell us the orientation of these planes, the width tells us the d-spacing, the angles of the intersections of the bands tell us about the crystal's symmetry and the intersections themselves identify poles.

Electron Backscatter Diffraction - Pattern Collection and Analysis

Materials Science Central Facilities Mike Meier University of California, Davis September 13, 2004



Figure 5 This in the indexed pattern shown in figure 3. It has been identified as a generic bcc structure that is oriented just off the [1-1 1] direction. Note the high confidence index of 0.69.



ACQUISITION OF KIKUCHI PATTERNS







centro

KIKUCI

ß

SIDO





Difração de elétrons retroespalhados – EBSD



35.00 µm = 70 steps KJ 5 2, 154

Figure 9 The pattern image quality map for a TaN-TiB, specimen produced by combustion synthesis. Lighter colored areas represent higher image quality and darker areas represent lower image quality. The darkest areas in this sample are either at grain boundaries, where two or more patterns are obtained simultaneously, and in the specimen's pores.



35 00 µm = 70 steps 10, 5 7, 154; Phase

Figure 10 The phase map for the TiN-TiB, specimen. The green areas represent the TiN phase (cubic) and the red areas represent the TiB₂ phase (hexagonal). The black represents areas of poor pattern image quality, such as it grain boundaries and in the pores.



Electron Backscatter Diffraction - Pattern Collection and Analysis

Materials Science Central Facilities Mike Meier University of California, Davis September 13, 2004 Figure 12 Pole figure plot showing the crystallographic texture in a calcium cerium titanate ceramic.



3D - Electron backscattering diffraction (EBSD)



S. ZAEFFERER, S.I. WRIGHT, and D. RAABE- METALLURGICAL AND MATERIALS** * TRANSACTIONS A - 374—VOLUME 39A, FEBRUARY 2008





Quasicrystals – Dan Schechtman Chemistry Nobel Prize 2011





Al-Mn diffraction patterns in D. Shechtman, I. Blech, D. Gratias, J.W. Cahn (1984) "Metallic phase with long range orientational order and no translation symmetry", Physical Review Letters 53 (20), pp 1951 – 1954.







Softwares

- Vesta: http://jp-minerals.org/vesta/en/
- Crystalbox: <u>https://www.fzu.cz/crystbox</u>
- JEMS: <u>http://www.jems-saas.ch/</u> (pago)
- Bancos de dados:
 - <u>http://www.crystallography.net/cod</u>
 - <u>http://rruff.info/</u>
 - http://scifinder-cas.ez27.periodicos.capes.gov.br/

SciFinder da CAS – acessivel para as Universidades, pago pela CAPES; necessita de cadastro prévio.

Alguns outros

http://www.freechemical.info/freeSoftware/kinds.php

